

【公報種別】特許法第17条の2の規定による補正の掲載

【部門区分】第3部門第1区分

【発行日】令和2年8月13日(2020.8.13)

【公表番号】特表2019-524620(P2019-524620A)

【公表日】令和1年9月5日(2019.9.5)

【年通号数】公開・登録公報2019-036

【出願番号】特願2018-569161(P2018-569161)

【国際特許分類】

C 01 B 32/188 (2017.01)

C 30 B 29/64 (2006.01)

【F I】

C 01 B 32/188

C 30 B 29/64

【手続補正書】

【提出日】令和2年6月26日(2020.6.26)

【手続補正1】

【補正対象書類名】特許請求の範囲

【補正対象項目名】全文

【補正方法】変更

【補正の内容】

【特許請求の範囲】

【請求項1】

表面(0001)の結晶方位を持つSiC結晶を、連続して：

a) 1×10^{-9} mbar未満の圧力とし；

d) 0.5 / 分から 10 / 分までの名目上のシリコン成長速度を生じる外部昇華源からのシリコン原子の流れの中で、 5×10^{-7} mbar以下の圧力下、1300 から 1800 までの温度でアニーリングすること

に供するという特徴を有する、シリコンカーバイドの表面にグラフェンを生産するための
方法。

【請求項2】

前記ステップa)と、前記ステップd)との間に、前記表面(0001)の結晶方位を持つ前記SiC結晶を、連続して：

b) 1×10^{-8} mbar以下の圧力下、300 から 900 までの温度でアニーリングすること；

c) 0.5 / 分から 2.5 / 分までの名目上のシリコン成長速度を生じる外部昇華源からのシリコン原子の流れの中で、900 から 1050 までの温度でアニーリングすること

にさらに供するという特徴を有する、請求項1のシリコンカーバイドの表面にグラフェンを生産するための方法。